

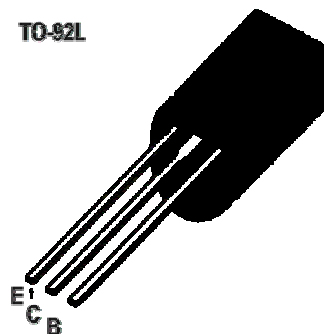
《风光欣》技术资料

T5609

NPN - silicon -

绝对最大额定值 (Ta=25)

项 目	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V _{CB0}	25	V
集电极-发射极电压	V _{CEO}	20	V
发射极-基极电压	V _{EBO}	5	V
集电极电流	I _c	1	A
集电极耗散功率	P _c	1	W
结 温	T _J	150	
存储温度	T _{STG}	-55 ~150	



电参数 (Ta=25)

项 目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} = 20V, I _E =0			1	μA
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} = 4V, I _C =0			1	μA
直流电流增益	H _{fe}	V _{CE} = 2V, I _c = 500mA	80	360		
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _c = 0.1mA, I _E =0	25			V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _c = 1mA, I _B =0	20			V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =0.1mA, I _C =0	5			V
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _c = 800mA, I _B = 80A		0.2	0.5	V
电流增益-带宽乘积	f _T	V _{CE} = 2V, I _E =500mA	150	350		MHZ
共基极输出电容	C _{OB}	V _{CB} = 10V, I _E =0, f=1MHZ		38.0		pF

Hfe 分档及其标志

分档	A	B	C	D
HFE(2)	80-120	85-170	120-240	180-360